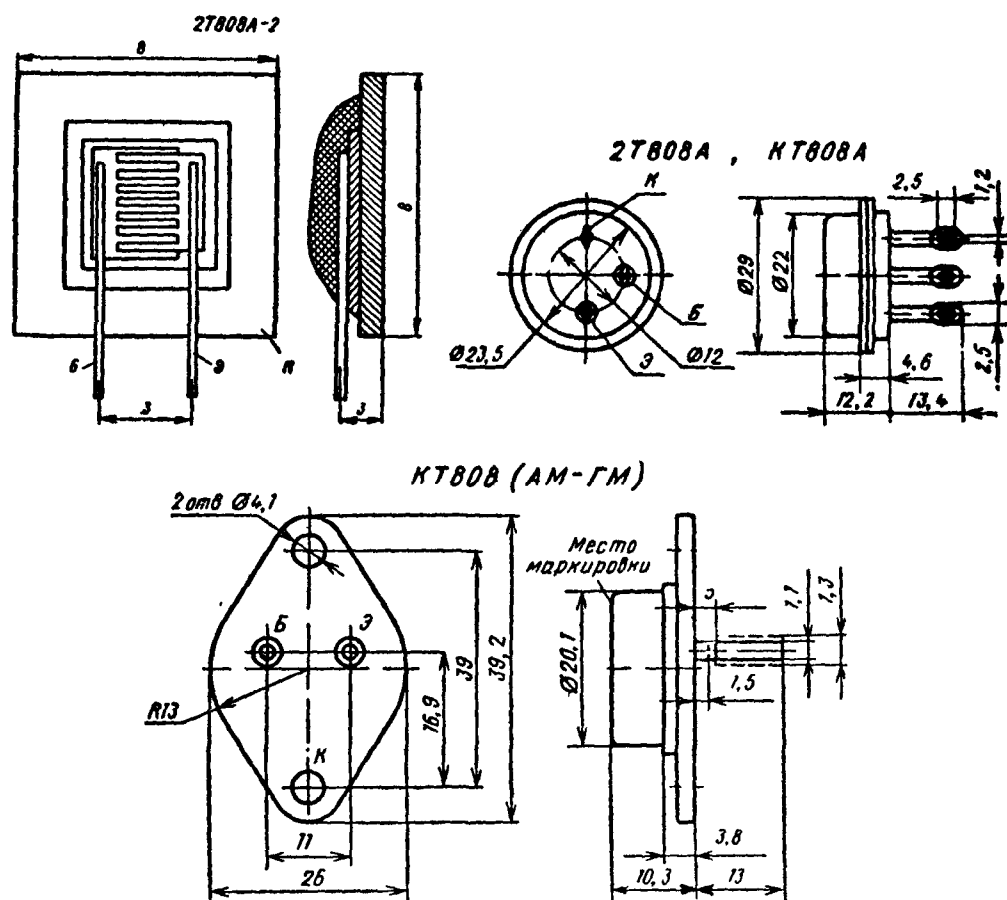


# 2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А, КТ808 (АМ, БМ, ВМ, ГМ)

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры  $p-n-p$  переключающего типа. Предназначены для применения в переключающих устройствах, генераторах строчной развертки, электронных регуляторах напряжения. Корпус транзисторов 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ — КТ808ГМ металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Транзистор 2Т808А-2 — бескорпусный на металлической молибденовой подложке с защитным покрытием и гибкими выводами.

Масса транзисторов 2Т808А, КТ808А (без накидного фланца) не более 22 г, КТ808АМ — КТ808ГМ — не более 20 г, 2Т808А-2 — не более 0,6 г.



## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:  
2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А при  $U_{кэ}=3$  В,  
 $I_k=6$  А:

$T=+25^\circ\text{C}$	10...15*...50
$T=+125^\circ\text{C}$ 2Т808А и $T=+100^\circ\text{C}$ КТ808А	10...20*...150
$T=-60^\circ\text{C}$	6...10*...50

КТ808АМ—КТ808ГМ при  $U_{кэ}=3$  В,  $I_k=2$  А

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при  $U_{кэ}=10$  В,  $I_b=0,5$  А,  $f=3,5$  МГц, не менее

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер КТ808АМ—КТ808ГМ при  $I_k=6$  А,  $I_b=0,6$  А, не более

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_k=6$  А,  $I_b=0,6$  А

Время рассасывания при  $U_{кэ}=15$  В,  $I_k=6$  А, не более

Обратный ток коллектор — эмиттер при  $R_{сэ}=10$  Ом, не более:

$T=+25$ и $-60^\circ\text{C}$ и $U_{кэ}=200$ В 2Т808А, 2Т808А-2 и $U_{кэ}=120$ В КТ808А	3 мА
---	------

$T=+125^\circ\text{C}$ , $U_{кэ}=160$ В 2Т808А, 2Т808А-2	20 мА
$T=+100^\circ\text{C}$ , $U_{кэ}=120$ В КТ808А	50 мА

Обратный ток коллектора КТ808АМ—КТ808ГМ при  $U_{кэ}=U_{кэ, макс}$ ,  $T=+25^\circ\text{C}$ , не более

Обратный ток эмиттера при  $U_{бэ}=4$  В, не более

Емкость коллекторного перехода при  $U_{кэ}=10$  В,  $f=1$  МГц, не более

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер<sup>1</sup> при  $R_{сэ}=10$  Ом,  $T_n \leq 100^\circ\text{C}$ :

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	120 В
КТ808АМ	130 В
КТ808БМ	100 В
КТ808ВМ	80 В
КТ808ГМ	70 В

Импульсное напряжение коллектор — эмиттер<sup>1</sup> при  $U_{бэ}=2$  В или  $R_{сэ}=10$  Ом,  $t_u \leq 500$  мкс,  $t_p \geq 30$  мкс,  $Q \geq 7$ ,  $T_n \leq +100^\circ\text{C}$

Постоянное напряжение эмиттер — база:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	4 В
КТ808АМ—КТ808ГМ	5 В

Постоянный ток коллектора

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T_n = -60...+50^\circ\text{C}$ :

с теплоотводом: 2Т808А, 2Т808А-2, КТ808А	50 Вт
КТ808АМ—КТ808ГМ	60 Вт
без теплоотвода 2Т808А, КТ808А	5 Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус

Температура  $p-n$  перехода

Температура окружающей среды:

2Т808А, 2Т808А-2, КТ808АМ—КТ808ГМ	$-60^\circ\text{C}...T_n=+125^\circ\text{C}$
КТ808А	$-60^\circ\text{C}...T_n=+100^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_n = +100...+150^\circ\text{C}$  постоянное и импульсное напряжения коллектор — эмиттер снижаются линейно на 10% на каждые  $10^\circ\text{C}$ . Температура перехода рассчитывается по формуле

$$T_n = T_{\text{н}} + R_{T(n-\text{н})}(P_k + P_b).$$

Механические усилия на выводы транзисторов не должны превышать 19,62 Н в осевом и 3,43 Н в перпендикулярном направлениях к оси вывода.

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора (от места выхода вывода из компаунда), температура пайки 2Т808А-2 не более  $+250^\circ\text{C}$ , 2Т808А, КТ808А, КТ808АМ — КТ808ГМ не более  $+275^\circ\text{C}$  в течение не более 3 с.

Допустимое значение статического потенциала 2Т808А-2 составляет 300 В.